

определяет искомую зависимость $\bar{B}(\xi)$. Отметим, что при $\xi \rightarrow H_{c1}$ производная $d\bar{B}/d\xi$ стремится к бесконечности по закону

$$\frac{d\bar{B}}{d\xi} \propto \frac{1}{\xi - H_{c1}} \ln^{-3} \frac{1}{\xi - H_{c1}}.$$

§ 49. Диамагнитная восприимчивость выше точки перехода

В конце § 45 уже было отмечено, что область температур вблизи T_c , в которой флуктуации параметра порядка ψ становятся большими, в сверхпроводнике чрезвычайно узка. Вне этой области флуктуационные поправки к термодинамическим величинам, вообще говоря, очень малы. Они могут, однако, оказаться существенными для магнитной восприимчивости металла выше точки перехода: появление вследствие флуктуаций даже относительно малого числа сверхпроводящих электронов может привести к вкладу в магнитную восприимчивость, превышающему обычно очень малую восприимчивость нормального металла вдали от точки перехода¹⁾.

Рассмотрим металл в слабом ($\xi \ll H_c$) внешнем магнитном поле при температуре выше точки T_c , но близкой к ней. Равновесное значение параметра порядка здесь $\psi = 0$, а для вычисления его флуктуаций можно использовать свободную энергию из теории Гинзбурга — Ландау. При этом в выражении (45,10) можно, в виду малости флуктуаций, сохранить только квадратичные по ψ члены, опустив член с $|\psi|^4$ и понимая под \mathbf{A} векторный потенциал однородного поля \mathfrak{H} . Флуктуации индукции \mathbf{B} , связанные с флуктуациями ψ , квадратичны по ψ (ввиду квадратичности плотности тока \mathbf{j}). Поэтому в члене $\mathbf{B}^2/8\pi$ можно понимать под \mathbf{B} среднее (термодинамическое) значение индукции, пренебрегая ее флуктуациями. Таким образом, изменение полной свободной энергии металла при флуктуации дается следующим выражением — функционалом от ψ^2):

$$\Delta F[\psi] = \int \left\{ \frac{1}{4m} \left| \left(-i\hbar\nabla - \frac{2e}{c}\mathbf{A} \right) \psi \right|^2 + a|\psi|^2 \right\} dV. \quad (49,1)$$

Для вычисления флуктуационного вклада ΔF в свободную энергию надо рассматривать функционал (49,1) как «эффектив-

¹⁾ Этот эффект был указан В. В. Шмидтом (1966).

²⁾ Во избежание недоразумений подчеркнем, что магнитное поле не является по отношению к сверхпроводнику «внешним полем» \hbar в том смысле, как оно было введено в V §-144. Последнее должно было входить в свободную энергию в виде члена $-\hbar(\psi + \psi^*)$, что в данном случае заведомо невозможно ввиду неинвариантности такого члена по отношению к выбору фазы ψ .

ный гамильтониан», определяющий ΔF согласно формуле

$$\exp\left(-\frac{\Delta F}{T}\right) = \int \exp\left(-\frac{\Delta F[\psi]}{T}\right) D\psi, \quad (49,2)$$

где интегрирование (функциональное) производится по всем распределениям $\psi(\mathbf{r})$ (см. V § 147). Фактически оно осуществляется путем разложения ψ по некоторой полной системе собственных функций и интегрированием по бесконечному множеству коэффициентов этого разложения. В случае однородной (без внешнего поля) системы разложение производится просто по плоским волнам (см., например, задачу в V § 147).

В данном же случае разложение следует производить по собственным функциям «уравнения Шредингера»

$$\frac{1}{4m} \left(-i\hbar\nabla - \frac{2e}{c} \mathbf{A} \right)^2 \psi = E\psi, \quad (49,3)$$

отвечающего гамильтониану (49,1). В § 47 уже было отмечено, что это уравнение формально совпадает с уравнением Шредингера для движения частицы (с массой $2m$ и зарядом $2e$) в однородном магнитном поле. Его собственные функции нумеруются одним дискретным (n) и двумя непрерывными (p_x , p_z) квантовыми числами, причем собственные значения зависят только от n и p_z (ось z в направлении \mathfrak{S}) и даются формулой

$$E\left(n + \frac{1}{2}, p_z\right) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{|e|\hbar}{mc} \mathfrak{S} + \frac{p_z^2}{4m}; \quad (49,4)$$

число различных собственных функций с заданным n , значением p_z в интервале dp_z и всеми возможными p_x есть

$$V \frac{2|e|\mathfrak{S}}{(2\pi\hbar)^2 c} dp_z$$

(см. III § 112).

Обозначим, для краткости, совокупность чисел n , p_z , p_x одним символом q и напомним разложение функции $\psi(\mathbf{r})$ в виде

$$\psi = \sum_q c_q \psi_q(\mathbf{r}), \quad (49,5)$$

где $c_q = c'_q + ic''_q$ — произвольные комплексные коэффициенты, а собственные функции предполагаются нормированными условием $\int |\psi_q|^2 dV = 1$ (интегрирование производится по объему металла).

Подстановка разложения (49,5) в (49,1) позволяет прежде всего перейти от интегрирования по объему к суммированию по q . Действительно, проинтегрировав первый член по частям, приводим (49,1) к виду

$$\Delta F[\psi] = \int \left\{ \psi^* \frac{1}{4m} \left(-i\hbar\nabla - \frac{2e}{c} \mathbf{A} \right)^2 \psi + \psi^* a \psi \right\} dV.$$

Подставив сюда (49,5) и учтя, что каждая из функций ψ_q удовлетворяет уравнению (49,3) с $E = E_q$ и что собственные функции с различными q взаимно ортогональны, получим

$$\Delta F [\Psi] = \sum_q |c_q|^2 (E_q + a). \quad (49,6)$$

Функциональное интегрирование в (49,2) означает интегрирование по всем $dc'_q dc''_q$. После подстановки (49,6) интегрирования по всем этим переменным разделяются и дают

$$\exp\left(-\frac{\Delta F}{T}\right) = \prod_q \frac{\pi T}{E_q + a},$$

или

$$\Delta F = -T \sum_q \ln \frac{\pi T}{E_q + a}. \quad (49,7)$$

В терминах квантовых чисел n и p_z это выражение записывается как

$$\Delta F = -V \frac{2|e|T\xi_0}{(2\pi\hbar)^2 c} \sum_n \int_{-\infty}^{\infty} \ln \frac{\pi T}{E(p_z, n+1/2) + a} dp_z. \quad (49,8)$$

Эта сумма расходится при больших E , но расходимость в действительности фиктивна и связана лишь с тем, что исходная формула (49,1) применима только при медленно меняющихся функциях $\psi(\mathbf{r})$: изменение ψ должно быть мало на расстояниях $\sim \xi_0$. В терминах собственных значений E_q это значит, что допустимы лишь $E_q \ll \hbar^2/m\xi_0^2$. Обрезав сумму по n при некотором большом N , удовлетворяющем поставленному условию, воспользуемся формулой Пуассона

$$\sum_{n=0}^N f\left(n + \frac{1}{2}\right) \approx \int_0^N f(x) dx - \frac{1}{24} f'(x) \Big|_0^N$$

(см. V (59,10)). В применении к (49,8) первый, интегральный, член этой формулы дает, как легко понять, не зависящий от ξ_0 вклад в свободную энергию; этот член не нужен для вычисления магнитной восприимчивости, и мы его опустим. Во втором же члене можно положить теперь $N \rightarrow \infty$ (так что параметр обрезания выпадает из ответа)¹⁾:

$$\Delta F = V \frac{e^2 T_c \xi_0^2}{48\pi^2 \hbar m c^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{a + p_z^2/4m}.$$

¹⁾ В коэффициенте положено $T \approx T_c$. При T вблизи T_c существенные в этом интеграле значения $p_z \sim \sqrt{ma} \sim \hbar/\xi_0(T) \ll \hbar/\xi_0$, т. е. удовлетворяют поставленному требованию.

Окончательно, после взятия интеграла,

$$\Delta F = V \frac{e^2 T_c \xi^2}{24\pi \hbar c^2 \sqrt{ma}}. \quad (49,9)$$

Отсюда магнитная восприимчивость

$$\chi = -\frac{1}{V} \frac{\partial^2 \Delta F}{\partial \xi^2} = -\frac{e^2 T_c}{12\pi \hbar c^2 (m\alpha)^{1/2} (T - T_c)^{1/2}} \quad (49,10)$$

(*H. Schmidt*, 1968; *A. Schmid*, 1969). Мы видим, что вблизи точки перехода восприимчивость возрастает как $(T - T_c)^{-1/2}$. В этой области (49,10) представляет собой основной вклад в магнитную восприимчивость нормального металла.

Задачи

1. Определить магнитный момент тонкой (толщина $d \ll \xi(T)$) пленки в перпендикулярном ее плоскости слабом магнитном поле при температурах $T > T_c$, $T - T_c \ll T_c$.

Решение. Конечность толщины пленки приводит к дискретности квантового числа p_z в (49,4), причем для тонкой пленки надо ограничиться в (49,7) лишь значением $p_z = 0$ (уже первое отличное от нуля значение $p_z \sim \hbar/d$, так что $E \sim \hbar^2/md^2 \gg \hbar^2/m\xi^2 \sim a$). Число собственных функций с заданными n и p_z (и всеми возможными p_x) есть $2|e|\xi S/2\pi\hbar c$, где S — площадь пленки; поэтому суммирование по q в (49,7) надо понимать как $(\xi S/\pi\hbar c) \sum_n$. Применив к сумме формулу Пуассона, получим в результате

$$\Delta F = S \frac{e^2 T_c \xi^2}{24\pi m c^2 a}.$$

Магнитный момент пленки

$$M = -\frac{\partial \Delta F}{\partial \xi} = -S \frac{e^2 T_c \xi}{12\pi m c^2 \alpha (T - T_c)}.$$

Обратим внимание на то, что он возрастает при $T \rightarrow T_c$ быстрее, чем в случае неограниченного металла.

2. То же для шарика радиуса $R \ll \xi(T)$ (*B. В. Шмидт*, 1966).

Решение. В этом случае из всех собственных значений уравнения (49,3) существенно лишь одно, наименьшее, отвечающее собственной функции $\psi = \text{const}$ и равное $E_0 = e^2 R^2 \xi^2 / 10 m c^2$ (см. все сказанное по этому поводу в задаче к § 47). Сумма (49,7) сводится к одному члену, и магнитный момент

$$M \approx -\frac{T_c}{a} \frac{\partial E_0}{\partial \xi} = \frac{e^2 T_c R^2 \xi}{5 m c^2 \alpha (T - T_c)}.$$

§ 50. Эффект Джозефсона

Рассмотрим два сверхпроводника, разделенных тонким слоем диэлектрика. Для электронов этот слой представляет собой потенциальный барьер, и если слой достаточно тонок, то существует конечная вероятность их проникновения через него путем квантового туннелирования. Даже если коэффициент про-